

当前位置: [科技部门户](#) > [新闻中心](#) > [科技动态](#) > [国内外科技动态](#)

【字体: 大 中 小】

韩国开发新一代快闪存储芯片

日期: 2017年05月05日 来源: 科技部

存储芯片行业在平面上增加存储数据的存储单元上存在着局限性,人们一直通过纵向堆积的3D技术来扩展容量。例如,韩国SK海力士(Hynix)公司的存储单元最高值为48层。该公司最近公布他们的技术可以将存储单元提升至72层。通过这一技术,该公司成功开发出72层256Gb容量的闪存存储芯片。

此前,三星电子于2016年年底开始了第四代产品,即堆积64层存储单元,批量生产了256Gb的快闪内存芯片,而此次SK海力士公司的72层叠层生产是世界首创。SK海力士对外公布称,可以最大限度地灵活使用现有的批量生产设备,比起现在正在生产的48层产品,其生产性能高出30%。此外,芯片内部适用高速电路设计,速度提高两倍,阅读和书写性能也提高了20%左右。

得益于人工智能、大数据、云存储等,人们对3D快闪的需求正大大增加。市场调查机构Gartner预测,今年全球快闪芯片市场规模为465亿美元,2021年将达到565亿美元。

[打印本页](#)

[关闭窗口](#)



版权所有: 中华人民共和国科学技术部

地址: 北京市复兴路乙15号 | 邮编: 100862 | [地理位置图](#) | ICP备案号: 京ICP备05022684